и величина $A^{(2)} = A_m^{(2)}$ этого максимума практически не зависят от внешнего магнитного поля. При $s^2 < \frac{4+\xi^4}{4\xi^2} \left(\frac{\varepsilon_1 \tau_1}{1+4\tau_1^2} + \frac{\varepsilon_2 \tau_2}{1+4\tau_2^2} \right)$ большему значению интенсивности внешнего магнитного поля соответствуют меньшие значения x_m и $A_m^{(2)}$. Это иллюстрируется рис. 1, на котором показано распределение функции $A_m^{(2)}/\beta_2$ в глубь полупространства из поликристаллического алюми-ния при $s^3 = 10^{-1}$, 10^{-2} , 10^{-3} , 10^{-4} , 10^{-5} , 0 (кривые 1—6 соответственно) для $\rho = 2,7 \cdot 10^4 \frac{\text{кr}}{\text{м}^3}$, $c_1 = 5,1 \cdot 10^3 \text{ м/c}$, $\beta = \frac{1}{3}$, $\Delta_0^{(1)} = 8 \cdot 10^{-4}$, $\sigma = 5 \times$ $\times 10^7$ Ом⁻¹ · м⁻¹, $\tau_1 = 70$, $\xi^2 = 22,6$. Численные расчеты производились в пренебрежении эффектами объемной вязкости в связи с их малостью по сравнению с эффектами, обусловленными сдвиговой вязкостью [9]. При выборе $\Delta_0^{(1)}$ и τ_1 использованы данные, приведенные в этой же работе.

На рис. 2 показана зависимость функции lg A⁽²⁾/β₂ максимального значения амплитуды волны перемещения второй гармоники от $|g \omega при s^2 = 10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 0$ (кривые 1—5 соответственно). Из графиков видно, что влияние внешнего магнитного поля на $A_m^{(2)}$ особенно существенно при высоких частотах. Минимум максимального значения $A_m^{(2)}$ амплитуды волны соответствует значению параметра $\tau_1 = \omega \tau_1 = l$

- 1. Бирак Я. И., Кондрат В. Ф. Магнитотермоупругие волны в полубесконечном электро-
- проводном теле. В кн.: Волны в сплошных средах. Кнев : Наук. думка, 1978, с. 85—92. 2. Дэйвис Р. М. Волны напряжений в твердых телах. — М. : Изд-во иностр. лит., 1961. — 102 c.
- 3. Зарембо Л. К., Красильников В. А. Нелинейные явления при распространении упругих волн в твердых телах.— Успехи физ. наук, 1970, 102, № 4, с. 549-586.
- 4. Кнопфель Г. Сверхсильные импульсивные магнитные поля. М.: Мир, 1972. 391 с. 5. Нагирный Т. С. Нелинейные уравнения магнитотермовязкоупругости. В кн.: Мате-Падарнай Т. С. Пелинейные уравнения магнитогермовязкопрутости.— В кн.: Материалы V конф. молодых ученых Льв. фил. мат. физики Ин-та математики АН УССР. Секция механики деформируемого твердого тела. Львов, 1978, с. 74—77.
 Новаку В. Введение в электродинамику.— М.: Изд-во иностр. лит., 1963.— 303 с.
 Підстригач Я. С., Бурак Я. И., Кондрат В. Ф. Магнітотермопружні процеси в електропровідних тілах при силовому навантаженні.— Вісн. АН УРСР, № 10, с. 12—21.
 Полякова А. Л. Нелинейные эффекты в твердых телах.— Физика твердого тела, 1964, 6. № 1.

- 6, № 1, c. 65-70.
- 9. Постников В. С. Внутреннее трение в металлах. М. : Металлургиздат, 1974. 351 с. 10. Селезов И. Т., Селезова Л. В. Волны в магнитогидроупругих средах. Киев : Наук. думка, 1975. 163 с.

Институт прикладных проблем хеханики и математики АН УССР Поступила в редколлегию 25.05.79

ЈДК 539.3: 538.569

А. Р. Гачкевич, Р. Ф. Терлецкий

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ И НАПРЯЖЕНИЯ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ УПРУГОМ СЛОЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

В данной работе определены и исследованы электромагнитные, тепловые поля и напряжения в слое, находящемся в периодическом во времени внешнем электромагнитном поле. При, этом влияние поля на процессы деформации и теплопроводности связывается только с выделением тепла, обусловленного трением, возникающем при переориентации диполей в переменном электромагнитном поле, и наличием чисто омической проводимости в диэлектрике, тю учитывается введением комплексной диэлектрической проницаемости и 🚓 дисперсией с частотой [2, 4, 9]. В отличие от известных в литературе работ до определению температурных полей в диэлектрике [4, 6], в которых тепловыделения усредняются во времени по периоду колебания электромагнитной волны и пренебрегается процессом теплопроводности [6], здесь учитывается периодический характер изменения во времени электромагнитного поля. Физико-механические характеристики слоя считаем постоянными и влиянием подвижности среды на электромагнитное поле пренебрегаем.

Рассмотрим упругий диэлектрический слой при заданной на поверхностях слоя z = 0, 1 напряженности электрического поля $E_x = E_0 e^{i\omega t}$, где ω — круговая частота; t — время; x, y, z — отнесенные к толщине слоя hдекартовые координаты. В области слоя отличными от нуля будут напряженности электрического $E_x(z, t) = E(z) e^{i\omega t}$ и магнитного $H_y(z, t) = H(z) e^{i\omega t}$ полей. Из системы уравнений Максвелла при комплексной диэлектрической проницаемости $\hat{\varepsilon} = \varepsilon' - i\varepsilon''$ [7, 9] получаем

$$E(z) = E_0 \frac{\operatorname{ch} \frac{k}{2} (2z - 1)}{\operatorname{ch} \frac{k}{2}},$$
 (1)

где $k = \beta + i\alpha; \ \beta = \frac{\omega h}{c} \sqrt{\varepsilon} \sin \frac{\delta}{2}; \ \alpha = \frac{\omega h}{c} \sqrt{\varepsilon} \cos \frac{\delta}{2}; \ \varepsilon = |\tilde{\varepsilon}|; \ \varepsilon'/\varepsilon'' = \delta$ где $\kappa = p + i\omega$, p - c, z = c, $z = \frac{1}{\sqrt{\frac{\varepsilon_0 \mu_0}{\varepsilon_0 \mu_0}}}$ электродинамическая постоянная. Не нарушая общности рассуждений, магнитную проницаемость среды и здесь и далее считаем равной единице.

Удельную плотность тепловых источников [2]

$$Q = \frac{\sigma}{2} \{ \operatorname{Re} \left[E(z) \ e^{i\omega t} \right] \}, \tag{2}$$

согласно работе [5], представим в виде $Q = Q^{(1)} + Q^{(2)}$. Злесь

$$Q^{(1)} = \frac{\sigma E_0^2}{2 (\cosh \beta + \cos \alpha)^2} [\cosh \beta (2z - 1) + \cos \alpha (2z - 1)];$$

$$Q^{(2)} = \frac{\sigma E_0^2}{4 (\cosh \beta + \cos \alpha)^2} \{ [\cos 2\alpha z \cosh 2\beta (z - 1) + \cos 2\alpha (z - 1) \cosh 2\beta z + 2\cos \alpha (2z - 1) \cosh \beta (2z - 1) + 2(1 + \cos \alpha \cosh \beta)] \cos 2\omega t - 2\cos \alpha (2z - 1) \cosh \beta (2z - 1) + \sin 2\alpha (z - 1) \sin 2\beta z + 2\sin \alpha (2z - 1) \sinh \beta (2z - 1) - 2\sin \alpha \sinh \beta] \sin 2\omega t \};$$
(3)

 $\sigma = \omega \varepsilon_0 \varepsilon''$ проводимость диэлектрика.

Температурные поля и напряжения находим для слоя, на свободных от силового нагружения основаниях которого поддерживается конвективный теплообмен с внешней средой. Температура среды T_0 . Полагая $u_x = u_y =$ = 0 и пренебрегая связанностью полей деформации и температуры, приходим к решению системы уравнений [5]

$$\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} - \frac{\partial T}{\partial \tau} = -\frac{h^2}{\lambda} Q(z, \tau),$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial z^2} - q^2 h^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = \frac{(1+\nu) \alpha_t h}{1-\nu} \frac{\partial T}{\partial z}$$
(4)

при начальных

$$T(z, 0) = 0, \quad u_z(z, 0) = 0, \quad \frac{\partial u_z(z, 0)}{\partial z} = 0$$
 (5)

и граничных

$$\frac{\partial T(0, \tau)}{\partial z} - \operatorname{Bi} T(0, \tau) = 0,$$

38

$$\frac{\partial T(1, \tau)}{\partial z} + \operatorname{Bi} T(1, \tau) = 0,$$

$$\frac{\partial u_{z}}{\partial z} = \frac{(1+\nu) \alpha_{l} h}{1-\nu} T \quad \text{при} \quad z = 0, 1$$
(6)

условиях, где $T(z, \tau)$ — отклонение температуры от начальной; $q^2 = \frac{(1-2\nu)\rho}{2(1-\nu)G}$; $\frac{1}{q}$ — скорость распространения поперечной волны; λ , a — коэффициенты тепло- и температуропроводности; α_t — коэффициент линейного расширения; E, G, ν — соответственно модуль упругости, модуль сдвига и коэффициент Пуассона; ρ — плотность; $\tau = \frac{at}{h^2}$ — критерий Фурье; Ві — критерий Био. Нормальные напряжения σ_x , σ_y , σ_z по найденным u_z и T определяются формулами [5]

$$\sigma_{z} = \frac{2G}{1-2\nu} \left[(1-\nu) \frac{\partial u_{z}}{\partial z} - \alpha_{t} (1+\nu) T \right],$$

$$\sigma_{x} = \sigma_{g} = \frac{2G}{1-2\nu} \left[\nu \frac{\partial u_{z}}{\partial z} - \alpha_{t} (1+\nu) T \right].$$
(7)

В соответствии с выражением для тепловых потерь температуру и перемещения представим в виде [5]

$$T = T^{(1)} + T^{(2)}, \quad u_z = u_z^{(1)} + u_z^{(2)},$$
 (8)

где T^{j} , u_{z}^{j} (j = 1, 2) удовлетворяют уравнениям (4) при сформулированных начальных и граничных условиях. Составляющие $T^{(1)}$, $u_{z}^{(1)}$ находим в квазистатической постановке [5], т. е. из системы уравнений

$$\frac{\partial^2 T^{(1)}}{\partial z^2} - \frac{\partial T^{(1)}}{\partial \tau} = - \frac{h^2}{\lambda} Q^{(1)},$$

$$\frac{\partial^2 u_z}{\partial z^2} = \frac{(1+\nu) \alpha_t h}{1-\nu} \frac{\partial T^{(1)}}{\partial z}$$
(9)

при начальном T(z, 0) = 0 и граничных условиях (6). Применяя конечное интегральное преобразование по z [1], получаем

$$T^{(1)}(z,\tau) = \frac{A}{2(\operatorname{ch}\beta + \cos\alpha)} \left\{ \frac{\cos\alpha (2z-1)}{4\alpha^2} - \frac{\operatorname{ch}\beta (2z-1)}{4\beta^2} + \frac{1}{\operatorname{Bi}} \left[\frac{\operatorname{sh}\beta}{2\beta} + \frac{\sin\alpha}{2\alpha} - \operatorname{Bi} \left(\frac{\cos\alpha}{4\alpha^2} - \frac{\operatorname{ch}\beta}{4\beta^2} \right) \right] - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{B_n^2 \beta_n^2} K(\beta_n, z) \left(\frac{\operatorname{Bi}}{\beta_n} K_n + L_n \right) e^{-\beta_n^2 \tau} \right\}.$$
(10)

Здесь

$$B_n^2 = \frac{1}{2\beta_n^3} \left[(\beta_n^2 + \operatorname{Bi}^2) \beta_n + 2 \operatorname{Bi} \beta_n \sin^2 \beta_n + (\beta_n^2 - \operatorname{Bi}) \sin 2\beta_n \right];$$

$$K \left(\beta_n, z\right) = \frac{\operatorname{Bi}}{\beta_n} \sin \beta_n \left(1 - z\right) + \cos \beta_n \left(1 - z\right); \quad A = \frac{\sigma E_0^2 h^2}{\lambda};$$

$$K_n = \frac{\beta_n \operatorname{ch} \beta \sin^2 \frac{\beta_n}{2} + \beta \operatorname{sh} \beta \sin \beta_n}{4\beta^2 + \beta_n^2} - \frac{\alpha \sin \alpha \sin \beta_n - \beta_n \cos \alpha \sin^2 \frac{\beta_n}{2}}{4\alpha^2 - \beta_n^2};$$

$$L_n = \frac{4\beta \operatorname{sh} \beta \cos^2 \frac{\beta_n}{2} + \beta_n \sin \beta_n \operatorname{ch} \beta}{4\beta^2 + \beta_n^2} + \frac{4\alpha \sin \alpha \cos^2 \frac{\beta_n}{2} - \beta_n \cos \alpha \sin \beta_n}{4\alpha^2 - \beta_n^2};$$

а β_а — пенулевые корни уравнения

$$\frac{\beta^2 - Bi^2}{2\beta Bi} = \operatorname{ctg} \beta.$$

Соответствующие температурные напряжения определяются формулами

$$\sigma_{z}^{(1)} = 0, \quad \sigma_{x}^{(1)} = \sigma_{y}^{(1)} = -\frac{\alpha_{t}E}{1-\nu}T^{(1)}.$$
 (11)

Функции $\mathcal{T}^{(2)}$, $u_2^{(2)}$ согласно выражениям (3) ищем в виде

$$T^{(2)} = \varphi(z) e^{2t\omega t} + \tilde{\varphi}(z) e^{-2t\omega t},$$

$$u_{z}^{(2)} = \chi(z) e^{2t\omega t} + \tilde{\chi}(z) e^{-2t\omega t}.$$
(12)

Из уравнений (4) и граничных условий (6) получаем -

$$\varphi(z) = \frac{A}{(4k^2 - \eta_1^2)(1 + \operatorname{ch} k)} \left[C_0 \left(C \operatorname{ch} \eta_1 z + \operatorname{sh} \eta_1 z \right) + \operatorname{ch} k \left(2z - 1 \right) - \frac{4k^2 - \eta_1^2}{\eta_1^2} \right],$$

$$\chi(z) = \frac{(1 + \nu) \alpha_4 h A}{(1 - \nu) \left(4k^2 - \eta_1^2 \right) (1 + \operatorname{ch} k)} \left[C_1 \cos \eta_2 z + C_2 \sin \eta_2 z + \frac{1}{(1 - \nu) \left(4k^2 - \eta_1^2 \right) (1 + \operatorname{ch} k)} + \frac{\eta_4}{\eta_1^2 + \eta_2^2} C_0 \left(C \operatorname{sh} \eta_1 z + \operatorname{ch} \eta_1 z \right) + \frac{2k}{\eta_2^2 + 4k^4} \operatorname{sh} k \left(2z - 1 \right) \right],$$

$$(13)$$

где

$$\sigma_{z}^{(2)} = \frac{4G}{1-2\nu} \operatorname{Re}\left\{\left[(1-\nu)\frac{d\chi}{dz} - \alpha_{t}(1+\nu)\varphi(z)\right]e^{2t\omega t}\right\},$$

$$\sigma_{x}^{(2)} = \sigma_{y}^{(2)} = \frac{4G}{1-2\nu} \operatorname{Re}\left\{\left[\nu\frac{d\chi}{dz} - \alpha_{t}(1+\nu)\varphi(z)\right]e^{2t\omega t}\right\}.$$
(14)

Численное исследование температурных полей и напряжений проводилось для слоя из стеклопластика CHK-2-27 толщиной $h < 2.5 \pm 10^{-2}$ м при следующих характеристиках материала [3, 8]: $\lambda = 0.43 \frac{\text{Br}}{\text{M} \cdot \text{град}}$; $a = 0.228 \times 10^{-6} \frac{\text{M}^2}{\text{C}^2}$; $\alpha_t = 0.11 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{град}}$; $E = 0.882 \cdot 10^{10} \frac{\text{H}}{\text{M}^2}$; $\nu = 0.28$; $\rho = 1.77 \times 10^3 \frac{\text{Kr}}{\text{M}^3}$.

Для исследуемых толщин слоя во всем диапазоне частот, приведенном в таблице, параметр $\beta = \frac{\omega \hbar}{c} \sqrt{\epsilon} \sin \frac{\delta}{2}$ является малым, так что с достаточссй для эрактических расчетов точностью можно принять ch $\beta \approx 1$.

4.

На рис. Ј представлено распределение усредненного по периоду колебаний электромагнитной волны $f = \frac{2\pi}{\omega}$ тепла $Q_* = \frac{2Q^{(1)}h}{\epsilon_0 c E_0^2} L(\omega)$ по толщине слоя. Численные значения параметра $L(\omega) = \frac{\epsilon^* \operatorname{tg} \delta}{\sqrt{\epsilon} \cos \frac{\delta}{2}}$ приведены в таблице. Кривые 1-5 на рис. 1 соответствуют значениям параметра α = $=\frac{\omega h}{\epsilon}\sqrt{\epsilon}\cos{\frac{\delta}{2}}=0.5;$ 1,5; 2,5; 4,5; 6. Как видно из графиков, неравномерность распределения удельных теп-Q ловыделений по толщине слоя определяется соотношением между толщиной 24 слоя h и длиной волны $\lambda_* = \frac{2\pi}{\alpha} h.$ 20 Если толшина слоя значительно меньшеλ, тепло равномерно распределено ws10⁻⁰ 16 20 12 ıб 12 8 A 4 0,4 Q,5 0,2 0,8 24 b.102 M Рис. 1 Рис. 2

со толщине. При толщинах порядка и меньше тепло распределено по толщине неравномерно. При этом для толщин слоя, равных полудлине волны, вмеют место явления типа резонанса. Резонансные частоты внешнего электромагнитного поля определяются соотношением

$$\omega_m \sqrt{\varepsilon} \cos \frac{\delta}{2} = \frac{\pi c (2m-1)}{h} \quad (m = 1, 2, \ldots).$$

Количественная оценка температурных полей и напряжений, которые соответствуют нагреву тепловыми источниками (2) и усредненными по периоду $Q^{(1)}$, показала, что температурные поля совпадают независимо от критерия Био, причем составляющая $T^{(2)}$ практически не зависит от него. Соответствующие температурные напряжения отличаются незначительно, за исключением окрестностей резонансных частот

$$\omega_n = \frac{\pi n}{2qh} \quad (n = 1, 2, \ldots),$$

тде напряжения о⁽²⁾ могут достигать значительных величин. Эти результаты совпадают с результатами, полученными в работе [5] по исследованию термоупругого поведения в электромагнитном поле электропроводного слоя.

На рис. 2 показана зависимость первых трех резонансных частот электромагнитного поля ω_n (n = 1, 2, 3) от толщины слоя при s = 1 (сплошные линии 1-3). На этом же рисунке при $s = 5 \cdot 10^{-5}$ (штриховые линии 1-3) показана зависимость от толщины слоя первых трех резонансных частот ω_m (m = 1, 2, 3). Следует отметить, что первые резонансные частоты ω_n лежат ниже области частот, применяемых обычно в практике при нагреве диэлектриков. На рис. 3 представлено распределение температуры $T_* =$

њ. Га	102	10ª	104	10*	10e	102	108	3.10*	3 • 109	1010
ε'	14,2	9,8	7,2	5,9	5,3	5,0	4,8	4,54	4,40	4,37
10ª tg δ	2500	2600	1600	800	460	340	260	240	290	360
L (ω)	1,0	1,3	2,3	5,3	9,4	13,0	17,5	20,0	16,4	11,6

 $=\frac{2\lambda T^{(1)}}{\epsilon_0 ch E_0^2} L$ (ω) по толщине слоя в установившемся режиме в зависимости от

значения параметра $\alpha = 0,5; 2,5; 4,5$ (кривые 1—3) и критерия Bi = 1 (сплошные линии), Bi = 10 (штриховые), Bi = 100 (штрихпунктирные). Кривые 1—3 характеризуют одновременно распределение напряжений $\sigma_* = 2(1-\nu) \lambda \sigma_*^{(1)}$

 $-\frac{2(1-v) \lambda \sigma_x^{(1)}}{\epsilon_0 c \alpha_t E h E_0^2} L (\omega).$ Зависимость температуры $T^{(1)}$ на основаниях слоя



в установившемся режиме от напряженности электрического поля E_0 при Ві = 1 и $h = 4,5 \cdot 10^{-2}$; 9 · 10⁻²; 13,5 · 10⁻²; 15 · 10⁻² м (кривые 1-4) для рассматриваемого материала приведена на рис. 4. Сплошные линии соответствуют частоте нагрева 10¹⁰ Гц, штриховые 3 · 10⁹ Гц и штрих-пунктирные 3 · 10⁸ Гц.

Из анализа полученных результатов следует, что в отличие от распределения джоулева тепла по толщине электропроводного слоя, находящегося под воздействием электромагнитного поля [5], распределение удельной плотности тепловыделений в диэлектрике существенно зависит от состношения между толщиной слоя и длиной волны λ_* . При этом при длине падающей волны, равной половине толщины слоя, имеют место наибольшие тепловыделения. Изменением длины волны можно существенно регулировать распределение тепловыделений, создавая при этом по толщине зоны более сильного и слабого нагрева.

- 1. Гринберг Г. А. Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. 728 с.
- Баценеленбаум Б. З. Высокочастотная электродинамика. М.: Наука, 1966. 240 с.
 Назаров Г. И., Сушкин В. В., Дмитриевская Л. В. Конструктивные пластмассы: Справсиевк. — М.: Машиностроение, 1973. — 190 с.

Нетушил А. В., Жуховицкий Б. М., Кудин В. Н., Парини Е. П. Высокочастотный нагрев диэлектриков и полупроводников.— М.; Л.: Госэнергоиздат, 1959.— 480 с.
 Подстригач Я. С., Бурак Я. И., Гачкевич А. Р., Черняская Л. В. Термоупругость элект-ропроводных тел.— Киев : Наук. думка, 1977.— 246 с.
 Рикенглаз А. Э. К теории нагрева диэлектриков мощными электромагнитными полями.— Инж.-физ. журн., 1974, 27, № 6, с. 1061—1068.
 Фрелих Г. Теория диэлектриков.— М.: Изд-во иностр. лит., 1960.— 251 с.
 Уилисть А. В. Пирактрики и их полимене — М.: П.: Госэнергоиздат, 1959.— 336 с.

- 8. Хиппель А. Р. Диэлектрики и их применение. М.; Л. : Госэнергоиздат, 1959. 336 с. 9. Хиппель А. Р. Диэлектрики и волны. М. : Изд-во иностр. лит., 1960. 438 с.

Институт прикладных проблем механики и математики АН УССР Поступила в редколлегию 19.11.79

УДК 539.3

Е. М. Федюк

УПРУГОЕ РАВНОВЕСИЕ ПОЛОГОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ С СИСТЕМОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ (ТРЕЩИН)

Рассмотрим изотропную пологую сферическую оболочку толщиной 2h. Пусть оболочка имеет N прямолинейных в плане произвольным образом расположенных параллельных сквозных трещин (разрезов) длиной $2l_{b}$ $(k = \overline{1, N})$. Предположим, что оболочка находится под действием внешней нагрузки, а к берегам разрезов приложены самоуравновешенные усилия и моменты. Считаем, что в процессе деформации оболочки при заданной нагрузке берега разрезов не контактируют.

Отнесем срединную поверхность оболочки к прямоугольной декартовой системе координат xOy, причем ось Ox направим параллельно линиям расположения разрезов. На каждом разрезе введем локальную систему координат $oldsymbol{x}_k O_k y_k$, начало которой совместим с центром разреза, а ось $O_k x_k$ направим по линии разреза. Центры разрезов в базисной системе координат хОу имеют координаты (x_k^0, y_k^0) , а оси $O_k x_k$ образуют с осью O x углы $\beta_k = 0$ или $\beta_k =$ = π. Напряженное состояние рассматриваемой оболочки можно представить в виде суммы напряженного состояния, вызванного внешней нагрузкой в оболочке без разрезов, и возмущенного, вызванного наличием разрезов (трещин). Задача сводится к нахождению возмущенного напряженного состояния, так как напряженное состояние сплошной оболочки определяется известными методами.

Используя предложенный в работах [3, 4] метод решения задач теории тонких оболочек с трещинами, для определения возмущенного напряженного **сос**тояния пологой сферической оболочки [1] с одной трещиной | $x_k | \leqslant l_k$, $y_k = 0$ получаем разрушающую систему дифференциальных уравнений от**нос**ительно функций φ_k (x_k , y_k) и w_k (x_k , y_k):

$$\nabla^{2}\nabla^{2}\varphi_{k} - \frac{D_{0}}{R} \nabla^{2}\omega_{k} = -D_{0} (\nabla^{2}_{1}\varepsilon^{0}_{22} - \nabla_{1}\nabla_{2}\varepsilon^{0}_{12}),$$

$$\nabla^{2}\nabla^{2}\omega_{k} + \frac{1}{DR} \nabla^{2}\varphi_{k} = -(\nu\nabla^{2}_{1} + \nabla^{2}_{2}) \varkappa^{0}_{22} - 2(1-\nu) \nabla_{1}\nabla_{2}\varkappa^{0}_{12}.$$
(1)

Здесь

$$\nabla^2 = \nabla_1^2 + \nabla_2^2; \quad \nabla_1 = \frac{\partial}{\partial x_k}; \quad \nabla_2 = \frac{\partial}{\partial y_k}; \quad D_0 = 2Eh; \quad D = \frac{2Eh^3}{3(1-v^2)};$$

E, v — модуль упругости и коэффициент Пуассона; R — радиус средин-вой поверхности оболочки; ε_{ij}^0 , κ_{ij}^0 — компоненты тензора дисторсии, характеризующие скачки перемещений и угла поворота на линии разреза и выражающиеся формулами

$$\begin{aligned} \varepsilon_{22}^{0}(x_{k}, y_{k}) &= \varepsilon_{2k}(x_{k})\,\delta(y_{k}), \quad \varepsilon_{12}^{0}(x_{k}, y_{k}) = \varepsilon_{3k}(x_{k})\,\delta(y_{k}), \\ \kappa_{22}^{0}(x_{k}, y_{k}) &= \kappa_{2k}(x_{k})\,\delta(y_{k}) + \kappa_{4k}(x_{k})\,\nabla_{2}\delta(y_{k}), \\ \kappa_{12}^{0}(x_{k}, y_{k}) &= \nabla_{1}\kappa_{4k}(x_{k})\,\delta(y_{k}), \end{aligned}$$
(2)

43